BEST AVAILABLE COP

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: WO 99/14806 (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: A1 H01L 23/373, 23/15, 25/065 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 25. Marz 1999 (25.03.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/02678

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. September 1998

(10.09.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 40 330.1

13. September 1997 (13.09.97) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GOEBEL, Ulrich [DE/DE]; Justinus-Kerner-Strasse 129, D-72760 Reutlingen (DE). HUBER, Elmar [DE/DE]; Unter dem Pflinzhöck 19a, D-99817 Eisenach (DE). HOEBEL, Albert-Andreas [DE/DE]; Schellingstrasse 43, D-72760 Reutlingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: DE, JP, US.

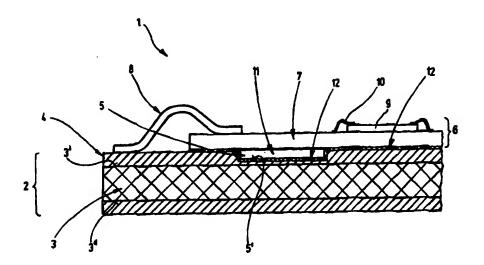
Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: CARRIER PLATE FOR MICRO-HYBRID CIRCUITS

(54) Bezeichnung: TRÄGERPLATTE FÜR MIKROHYBRIDSCHALTUNGEN



(57) Abstract

The invention relates to a carrier plate (2) for micro-hybrid circuits (7) with a ceramic body (3). According to the invention, the ceramic body (3) is porous and the cavities of said body are filled in with aluminum. A very good thermal binding of the micro hybrid circuits (7) onto the carrier plate (2) is possible due to the relatively small variances in the thermal recess coefficients of the carrier plate (2) and micro-hybrid circuit (7).

(57) Zusammenfassung

4

Die Erfindung betrifft eine Trägerplatte (2) für Mikrohybridschaltungen (7) mit einem Keramikkörper (3). Erfindungsgemäß ist vorgesehen, daß der Keramikkörper (3) ein poröser Körper ist, dessen Hohlräume mit Aluminium ausgefüllt sind. Aufgrund der relativ kleinen Unterschiede im thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Trägerplatte (2) und Mikrohybridschaltung (7) ist eine sehr gute thermische Anbindung der Mikrohybridschaltungen (7) an die Trägerplatte (2) möglich.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadachikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	II.	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Victnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dånemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

WO 99/14806 PCT/DE98/02678

1

Trägerplatte für Mikrohybridschaltungen

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft eine Trägerplatte für Mikrohybridschaltungen mit einem Keramikkörper.

Eine gattungsgemäße Trägerplatte ist in der Patentschrift US 5,576,934 offenbart. Sie besteht aus einer Keramikplatte, die auf ihrer Ober- und ihrer Unterseite mit einer Metallhaut aus Kupfer überzogen ist. Die Keramikplatte ist mit Ausnehmungen versehen, die von der Kupferhaut überbrückt werden. Diese Ausnehmungen dienen dazu, auf der Unterseite der Mikrohybridschaltungen angeordnete Bauteile aufzunehmen. Bei der Montage von Mikrohybridschaltungen auf der Trägerplatte wird die Kupferhaut im Bereich der Ausnehmungen eingedrückt, so daß diese Bauteile, insbesondere Wärme produzierende integrierte Schaltungen, in den Ausnehmungen aufgenommem werden. Die thermische Anbindung der Bauteile an die Trägerplatte erfolgt über wärmeleitende Substanzen, insbesondere wärmeleitende Klebstoffe, die zwischen den Bauteilen und der Trägerplatte aufgebracht werden. Auf diese Weise kann die von den

Bauteilen abgegebene Wärme direkt über die Trägerplatte abgeführt werden.

Der Aufbau von Mikrohybridschaltungen ist aber individuell verschieden. Daher kann man keine standardisierten Trägerplatten einsetzen, sondern muß sie einzeln mit den passenden Ausnehmungen versehen. Die Herstellung derartiger Trägerplatten ist daher sehr aufwendig und folglich auch sehr teuer.

Ein generelles Problem ist ferner die thermische Anbindung der Mikrohybridschaltungen auf der Trägerplatte. Dies liegt an den unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Die oben beschriebene Lösung mit wärmeleitenden Zwischenschichten erfordert zusätzliche Komponenten und Verfahrensschritte. Sie ist daher ebenfalls umständlich und teuer.

Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemäße Trägerplatte, deren Keramikkörper ein poröser Körper ist, dessen Hohlräume mit
einer metallischen Substanz infiltriert sind, hat
demgegenüber den Vorteil, daß eine sehr gute thermische Anbindung von Bauteilen bzw. der Substratoberfläche einer Mikrohybridschaltung möglich ist.
Die Trägerplatte zeichnet sich durch eine hohe
thermische Leitfähigkeit und einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aus. Aufgrund des
relativ kleinen Unterschiedes zwischen den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Mikrohybridschaltung bzw. Trägerplatte können beide mit einer
sehr dünnen Klebeschicht und ohne große Verspannun-

gen miteinander verbunden werden. Es ist nicht mehr notwendig, spezielle wärmeleitende Substanzen einzusetzen.

Derartige Trägerplatten sind durch einen Infiltrationsprozeß erhältlich, bei dem die Hohlräume mit dem Metall ausgefüllt werden. Dieser Materialtyp ist unter der Bezeichnung "Metal Matrix Composite" (im folgenden: MMC) bekannt.

Durch die in den Unteransprüchen genannten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der in Anspruch 1 angegebenen Trägerplatte möglich.

Besonders vorteilhaft ist es, die Trägerplatte mit einer zusätzlichen Metallhaut zu überziehen, welche insbesondere mit layout-spezifischen Vertiefungen versehen werden kann. Damit erhält man layout-spezifisch strukturierte Oberflächen unter Verwendung eines standardisierten Keramikkörpers. Die Herstellung derartiger layout-spezifischer Trägerplatten ist daher einfach und kostengünstig.

Ein bevorzugtes Material ist Al-Si-Cermet. Es besteht aus einer porösen SiC-Keramik, dessen Hohlräume mit Aluminium ausgefüllt sind. Eine daraus bestehende Trägerplatte kann dann mit einer Metallhaut aus Aluminium überzogen sein. Da Aluminium ein leicht bearbeitbares Metall ist, können die layoutspezifischen Strukturen sowohl durch mechanische Bearbeitung der Aluminiumschicht als auch durch Einsätze im Infiltrations- oder Gießwerkzeug eingebracht werden. Damit können Änderungen der Oberflä-

chenstrukturen schnell realisiert werden. Auch dadurch gestaltet sich das Herstellungsverfahren einfach und kostengünstig.

Derartige Trägerplatten können z.B. aber auch lokal in größere Aluminium-Gußteile eingebracht werden. Auf diese Weise kann man eine Verbindung der bzgl. des thermischen Ausdehnungskoeffizienten angepaßten Trägerplatte mit einem Gußgehäuse für Mikrohybridsteuergeräte realisieren. Damit reduziert sich die Anzahl der Montageschritte. Ferner kann Keramikmaterial eingespart werden. Die Schlagzähigkeit der MMCs wird erhöht. Schließlich ist eine freie Formteilgestaltung analog zu reinen Gußteilen möglich.

Eine derartige Einbettung in Gußteile ist nicht nur bei Al-Si-Cermets möglich, sondern mit allen Metallen, mit denen die MMCs hergestellt werden können.

Ferner können zusätzliche isolierende Schichten und/oder metallische Schichten auf die Trägerplatte aufgebracht werden. In Verbindung mit zusätzlichen Isolationsschichten ist eine Isolation der Mikrohybridschaltung gegenüber der Trägerplatte mit hoher Spannungsfestigkeit möglich. Damit wird die ESD-Festigkeit erhöht. Derartige Bauteile können für Hochspannungsanwendungen eingesetzt werden.

Zusätzliche Metallschichten bieten die Möglichkeit, eine zusätzliche Abschirmlage (z.B. Elektronikmasse) unabhängig vom Potential der Trägerplatte einzubringen. Die Metallhaut kann ferner strukturiert sein, so daß die Trägerplatte zusätzlich als Verdrahtungsebene genutzt werden kann. Auch diese Maßnahme spart Herstellungskosten.

Die erfindungsgemäße Trägerplatte erlaubt also auf einfache, kostengünstige Weise eine Vielzahl von Variationen für Mikrohybridschaltungen, je nach konkreter Anwendung.

Zeichnung

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

- Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Trägerplatte mit darauf befestigter Mikrohybridschaltung;
- Figur 2 eine Darstellung eines zweiten
 Ausführungsbeispiels analog zu Figur 1;
- Figur 3 eine Darstellung eines dritten
 Ausführungsbeispiels analog zu Figur 1.

Figur 1 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Einheit 1 mit einer erfindungsgemäßen Trägerplatte 2 in Form eines MMC-Kühlkörpers und einem elektronischen Bauteil 6.

Die Trägerplatte 2 besteht aus einem Keramikkörper 3 aus Al-Si-Cermet. Dabei handelt es sich um eine

porose SiC-Keramik, deren Hohlräume mit Aluminium infiltriert sind. Der Herstellungsprozeß ist an sich bekannt; diese Materialien können z.B. von den Firmen Alcoa oder Lanxide bezogen werden. Der Keramikkörper 3 ist je nach Anwendung etwa 0,3 bis 2 mm dick.

Der Keramikkörper 3 ist an seiner Oberseite 3' und an seiner Unterseite 3'' von einer Metallhaut 4 aus Aluminium überzogen. Die Schichtdicke der Metallhaut 4 beträgt etwa 0,6 mm.

Das in Figur 1 schematisch dargestellte Bauteil 6 besteht aus einer Mehrschicht-Mikrohybridschaltung 7 und zwei integrierten Schaltkreisen 9 und 11. Derartige Mikrohybridschaltungen 7 bestehen im allgemeinen aus einem keramischen Material und können verschiedene Komponenten (wie z.B. Widerstände oder Transistoren) aufweisen, die in die einzelnen Schichten integriert sind. Sie sind mittels Drähten 8, z.B. Al-Drahtbonden, mit hier nicht dargestellten externen Anschlüssen oder mit leitenden Strukturen auf der Metallhaut 4 der Trägerplatte 2 verbunden.

Die Mikrohybridschaltung 7 ist im Ausführungsbeispiel mit zwei intergrierten Schaltkreisen 9 und 11, z.B. Flip-Chip-IC's ausgestattet. Der Schaltkreis 9 ist auf der Oberseite 7' der Mikrohybridschaltung 7 angeordnet und über Drähte 10 mit leitenden Strukturen auf Oberseite 7' der Mikrohybridschaltung verbunden. Der Schaltkreis 11 befindet sich auf der Unterseite 7'' der Mikrohybridschaltung 7.

Die Metallhaut 4 weist eine Vertiefung 5 auf, die den integrierten Schaltkreis 11 auf der Unterseite Mikrohybridschaltung 7 aufnimmt. Schichtdicke der Metallhaut 4 beträgt an dieser Stelle nur noch 0,1 bis 0,2 mm. Die Vertiefung 5 ist layout-spezifisch, d.h. sowohl hinsichtlich ihrer Größe als auch hinsichtlich ihrer Position in der Metallhaut 4 individuell auf Größe und Position des Schaltkreises 11 auf der Unterseite 7'' der Mikrohybridschaltung 7 abgestimmt. Die Vertiefung 5 kann durch mehrere Methoden eingebracht werden. Bei Kleinserien bietet sich eine mechanische Bearbeitung, z.B. Fräsen an. Insbesondere Aluminium kann sehr leicht mechanisch bearbeitet werden. Damit kann die Vertiefung 5 auch schnell an Änderungen im Layout der Mikrohybridschaltung 4 angepaßt werden. Eine andere Möglichkeit, die insbesondere bei Großserien vorteilhaft ist, besteht darin, die Vertiefung 5 während der Herstellung der Trägerplatte 2 anzubringen, z.B. mit Einsätzen im Infiltrationsbzw. Gießwerkzeug.

Die erfindungsgemäße Trägerplatte 2 zeichnet sich durch eine hohe thermische Leitfähigkeit und einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten aus, der demjenigen der Mikrohybridschaltung vergleichbar ist. Daher genügt es, die Mikrohybridschaltung 7 ohne Vorspannung lediglich mit einer dünnen Schicht aus einem Leitkleber 12 auf der Trägerplatte 2 zu fixieren. In der resultierenden Einheit 1 treten, bedingt durch die vergleichbaren thermischen Ausdehnungskoeffizienten, keine nennenswerten Spannungen auf, die die Festigkeit der Verbindung

zwischen Mikrohybridschaltung 7 und Trägerplatte 2 in relevantem Ausmaß beeinträchtigen könnten.

Durch die dünne Schicht des Leitklebers 12 kann auch die von den Schaltkreisen 9, 11 produzierte Wärme direkt an die erfindungsgemäße Trägerplatte 2 abgegeben werden, ohne daß es der Zwischenschaltung einer Schicht aus einer speziellen wärmeleitenden Substanz bedürfte. Da die erfindungsgemäße Trägerplatte 2 selbst gut wärmeleitend ist, wird die Wärme auch schnell und problemlos nach außen abgeführt.

Bei der Montage der Mikrohybridschaltung 7 auf der Trägerplatte 2 wird auch der Schaltkreis 11 in der Vertiefung 5 mit Leitkleber 12 fixiert.

Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel einer Trägerplatte 2' in im wesentlichen derselben Anordnung wie Figur 1. Der einzige Unterschied besteht darin, daß auf der Metallhaut 4 der Trägerplatte 2' eine isolierende Schicht 13, z.B. aus einem keramischen Material oder einem Kunststoff vorgesehen ist. Der Mikrohybridschaltkreis 7 ist auf dieser Schicht 13 befestigt. Derartige Anordnungen erhöhen die ESD-Festigkeit und sind für Hochspannungsanwendungen geeignet.

Figur 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Trägerplatte 2'', bei der auf der Metallhaut 4 eine weitere metallische Schicht 14 aufgebracht ist. Die Schicht 14 befindet sich auf einem anderen elektrischen Potential als die Trägerplatte 2. Derartige Schichten 14 bieten eine

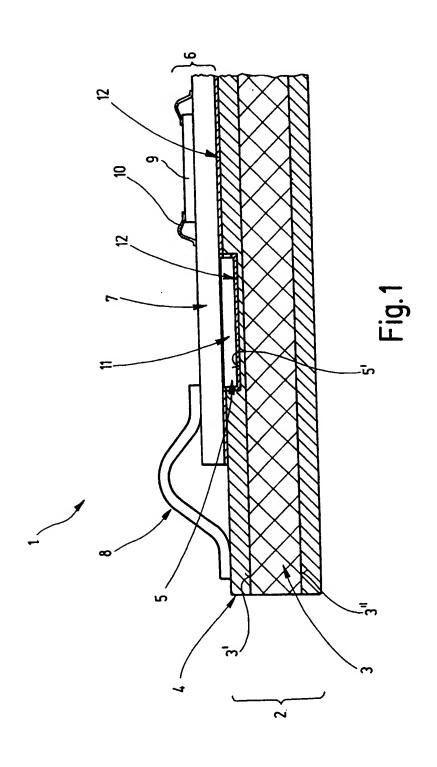
zusätzliche Abschirmlage unabhängig vom Potential der Trägerplatte 2 in Figur 1.

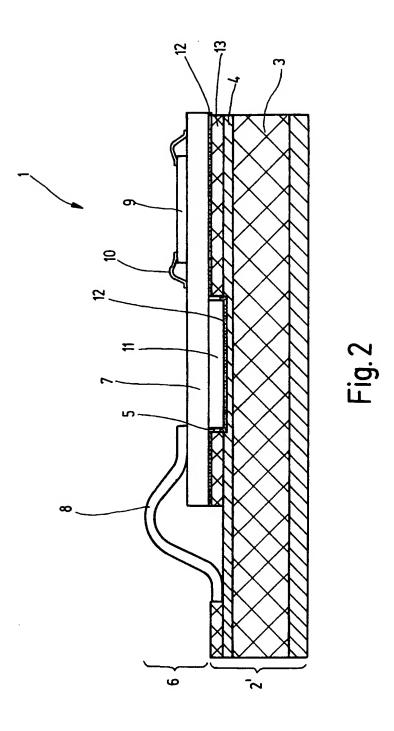
Patentansprüche

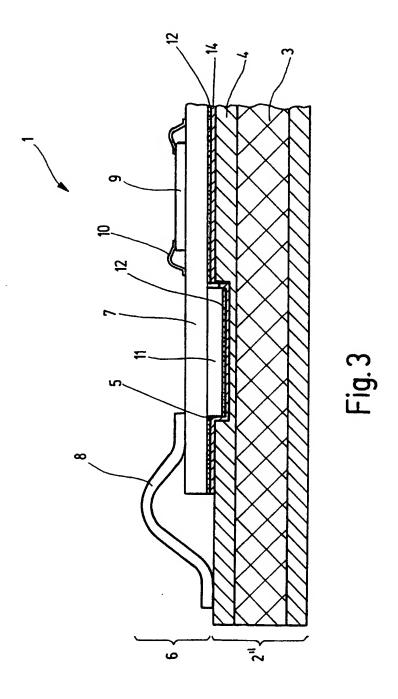
- 1.Trägerplatte (2) für Mikrohybridschaltungen (7) mit einem Keramikkörper, dadurch gekennzeichnet, daß der Keramikkörper (3) ein poröser Körper mit Hohlräumen ist, wobei die Hohlräume mittels eines Infiltrations- bzw. Gießwerkzeugs mit einer metallischen Substanz infiltriert sind, und daß der Keramikkörper (3) zusätzlich mittels des Infiltrations-bzw. Gießwerkzeugs mit einer Metallhaut (4) überzogen ist.
- 2. Trägerplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke der Metallhaut (4) etwa 0,4 bis 0,8 mm, vorzugsweise etwa 0,6 mm beträgt.
- 3. Trägerplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Metallhaut (4) einen oder mehrere Bereiche mit reduzierter Schichtdicke aufweist, die layoutspezifische Vertiefungen (5) zur Aufnahme von Bauteilen (11) der Mikrohybridschaltungen (7) bilden.
- 4. Trägerplatte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke der Bereiche etwa 0,1 bis 0, 2 mm beträgt.
- 5. Trägerplatte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das verwendete Metall Aluminium ist.

- 6. Trägerplatte nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß sie lokal in bestimmten Bereichen eines Aluminium-Gußteiles eingebracht ist.
- 7. Trägerplatte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens eine zusätzliche isolierende Schicht (13) und/oder mindestens eine zusätzliche Metallschicht (14) aufweist.
- 8. Trägerplatte nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzliche Metallschicht (14) sich auf einem gegenüber den restlichen Schichten unterschiedlichen elektrischen Potential befindet.
- 9. Trägerplatte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Metallschicht (4, 14) für Verdrahtungszwecke strukturiert ist.
- 10. Gußteil, insbesondere Aluminiumgußteil, mit darin eingebrachter Trägerplatte mit Keramikkörper für Mikrohybridschaltungen, dadurch gekennzeichnet, daß der Keramikkörper (3) ein poröser Körper mit Hohlräumen ist, wobei die Hohlräume mittels eines Infiltrations- bzw. Gießwerkzeugs mit einer metallischen Substanz infiltriert sind, daß der Keramikkörper (3) zusätzlich mittels des Infiltrations- bzw. Gießwerkzeugs mit einer Metallhaut (4) überzogen ist und daß die Trägerplatte in das Gußteil eingebettet ist, wobei die Einbettung zusammen mit der Herstellung des Gußteils erfolgt ist und das Gußteil sowie die Metallhaut und die metallische Substanz aus dem gleichen Metall sind.

- 11. Verfahren zur Herstellung von Trägerplatten (2) für Mikrohybridschaltungen (7) mit einem porösen Keramikkörper, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Infiltrations- bzw. Gießwerkzeug Hohlräume des Keramikkörpers mit einer metallischen Substanz infiltriert werden und der Keramikkörper mit einer Metallhaut überzogen wird.
- 12. Verfahren zur Herstellung von Gußteilen mit darin eingebrachter Trägerplatte mit Keramikkörper für Mikrohybridschaltungen, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Infiltrations- bzw. Gießwerkzeug Hohlräume des Keramikkörpers mit einer metallischen Substanz infiltriert werden, der Keramikkörper mit einer Metallhaut überzogen wird und eine Einbettung der Trägerplatte in das Gußteil erfolgt.







INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In itional Application No PCT/DE 98/02678

IPC 6	H01L23/373 H01L23/15 H01L25/0	65	·					
A second lead to the second se								
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED								
	cumentation searched (classification system followed by classification H01L	in symbols)						
	tion searched other than minimum documentation to the extent that so							
		o ale. Who o planta and a second						
	C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document with indication, where appropriate of the relevant passages Relevant to Claim No.							
Category '	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	avant passages	riciaran to deliti to.					
X Y	US 5 650 592 A (CHESKIS HARVEY ET AL) 22 July 1997 see the whole document 1,2,5, 10-12 6-9							
Y	US 5 570 502 A (PREMKUMAR M K ET AL) 6-9							
	5 November 1996 see the whole document							
A	US 5 526 867 A (ROCAZELLA MICHAEL A ET 1-12 AL) 18 June 1996 see the whole document							
Ρ,Χ	GB 2 311 414 A (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD) 1,5,6, 24 September 1997 10-12 see the whole document							
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.					
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	"I" later document published after the inte or pnority date and not in conflict with cited to understand the principle or th invention	the application but					
filing o	E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to the country of the considered to the							
citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled								
	"P" document published prior to the international filing date but in the art. later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family							
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report					
2	February 1999	10/02/1999						
Name and r	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer						
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epa ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Prohaska, G						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Inte onal Application No
PCT/DE 98/02678

	ent document n search report			Patent family member(s)	Publication date	
US 5	650592	A	22-07-1997	NONE	•	
US 5	5570502	A	05-11-1996	US	- 5259436 A	09-11-1993
				US	5616421 A	01-04-1997
				US	5775403 A	07-07-1998
				ÜS	5746267 A	05-05-1998
				EP	0538457 A	28-04-1993
				ĴΡ	5508350 T	25-11-1993
				WO	9217297 A	15-10-1992
US S	 5526867	Α	18-06-1996	US	5163499 A	17-11-1992
				US	5040588 A	20-08-1991
				ĀŤ	155287 T	15-07-1997
				AU	651822 B	04-08-1994
				AU	7685191 A	18-09-1991
				CA	2076637 A	24-08-1991
				DE	69126773 D	14-08-1997
				EP	0516765 A	09-12-1992
				JP	5504659 T	15-07-1993
				WO	9113462 A	05-09-1992
				AT	143620 T	15-10-1996
				AU	647024 B	17-03-1994
				AU	5807090 A	10-01-1991
				CA	2020676 A	08-01-1991
				DE	69028740 D	07-11-1996
				DE	69028740 T	13-02-1997
				EP	0407331 A	09-01-1991
				JP	3138327 A	12-06-1991
				AT	114735 T	15-12-1994
				AU	649561 B	26-05-1994
				AU	23 5 3 79 2 A	19-11-1992
				AU	624418 B	11-06-1992
				AU	4170489 A	17-05-1990
				CA	2000790 A	10-05-1990
				CN	1042497 A	30-05-1990
				DE	68919652 D	12-01-1995
				DK	559789 A	11-05-1990
				EP	0369931 A	23-05-1990
				FΙ	91496 B	31-03-1994
				ΙE	66713 B	24-01-1996
				JP	2240229 A	25-09-1990
				NO	177583 B	10-07-1995
				PH	26794 A	13-10-1992
				PT	92261 A,B	31-05-1990
				US	5618635 A	08-04-1997
GB 2	2311414	A	24-09-1997	GB	2327150 A	13-01-1999
				JP	10150124 A	02-06-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte onales Aktenzeichen
PCT/DE 98/02678

A. KLASSII IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L23/373 H01L23/15 H01L25/0	65			
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK			
	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchier IPK 6	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo . H01L	ele)			
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so				
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete Suc	hbegnife)		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie ³	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
X Y	US 5 650 592 A (CHESKIS HARVEY E 22. Juli 1997 siehe das ganze Dokument	T AL)	1,2,5, 10-12 6-9		
γ	US 5 570 502 A (PREMKUMAR M K ET	· AL)	6-9		
	5. November 1996 siehe das ganze Dokument 				
A	US 5 526 867 A (ROCAZELLA MICHAEL AL) 18. Juni 1996 siehe das ganze Dokument	A ET	1-12		
Р,Х	GB 2 311 414 A (FURUKAWA ELECTRIC 24. September 1997 siehe das ganze Dokument	CO LTD)	1,5,6, 10-12		
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie			
"A" Veroffe aber n "E" älteres	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem int oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht wo Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zu Erfindung zugrundellegenden Prinzips ode Theorie angegeben ist	orden ist und mit der im Verständnis des der		
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindur					
ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeidedatum, aber nach "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeidedatum, aber nach					
	eanspruchten Priontatsdatum veroffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Reche			
	. Februar 1999	10/02/1999			
Name und I	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter	.,		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Prohaska, G			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ångaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/DE 98/02678

	echerchenberich rtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Datum der Patentfamilie Veröffentlichung		Datum der Veröffentlichung
US	5650592	Α	22-07-1997	KEIN	IE	
· HS-	5570502	A.	05-11-1996	· US-	5259436 A	09-11-1993
•	55, 5552	• •	***************************************	ÜS	5616421 A	01-04-1997
				ÜŠ	5775403 A	07-07-1998
				US	5746267 A	05-05-1998
				EP	0538457 A	28-04-1993
				ĴΡ	5508350 T	25-11-1993
				WO	9217297 A	15-10-1992
US	5526867	Α	18-06-1996	US	5163499 A	17-11-1992
		• •		US	5040588 A	20-08-1991
				AT	155287 T	15-07-1997
				AU	651822 B	04-08-1994
				AU	7685191 A	18-09-1991
				CA	2076637 A	24-08-1991
				DE	69126773 D	14-08-1997
				ĒΡ	0516765 A	09-12-1992
				JР	5504659 T	15-07-1993
				WO	9113462 A	05-09-1992
				AT	143620 T	15-10-1996
				AU	647024 B	17-03-1994
				AU	5807090 A	10-01-1991
				CA	2020676 A	08-01-1991
				DE	69028740 D	07-11-1996
				DE	69028740 T	13-02-1997
				EP	0407331 A	09-01-1991
				JP	3138327 A	12-06-1991
				AT	114735 T	15-12-1994
				AU	649561 B	26-05-1994
				AU	2353792 A	19-11-1992
				AU	624418 B	11-06-1992
				AU	4170489 A	17-05-1990
				CA	2000790 A	10-05-1990
				CN	1042497 A	30-05-1990
				DE	68919652 D	12-01-1995
				DK	559789 A	11-05-1990
				EP	0369931 A	23-05-1990
				FI	91496 B	31-03-1994
				IE	66713 B	24-01-1996
				JP	2240229 A	25-09-1990
				NO	177583 B	10-07-1995
				PH	26794 A	13-10-1992
				PT US	92261 A,B 5618635 A	31-05-1990 08-04-1997
GB	2311414	Α	24-09-1997	GB	2327150 A	13-01-1999
				JP	10150124 A	02-06-1998

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.